

スパッタリング装置 SP-3300



本装置は3源スパッタ装置で、300Wの高周波電源を1台搭載しております。整合器は自動整合器を搭載。整合は手動はもちろんのこと自動でも調節可能です。

又、真空中にTS間の距離を可変可能な構造となっておりますので成膜レートの調整も出来ます。

基板加熱は最高350℃迄昇温可能。実験用の小型スパッタリング装置としては十分な機能を兼ね備えております。

排気系はターボ分子ポンプによるクリーンな排気で、金属膜、酸化膜、絶縁膜の良質な成膜が可能です。

スパッタリング装置SP-3300仕様

- 到達圧力 1.0×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 成膜室径 φ350mm×341mmH SUS304 電解研磨
- スパッタ用電源 RF電源 13.56MHz 300W 自動マッチング 1台
- 基板形状 φ2インチウエハー 1枚
- 膜厚分布 φ25mm領域において±10%以内
- ターゲット寸法 3インチ(金属・酸化物・絶縁物)
- ターゲット個数 3
- 基板加熱 常温～350℃迄昇温可能
- 真空排気系 油回転ポンプ:200L/min[60Hz]
ターボ分子ポンプ:300L/sec
- 操作方法 手動
- ガス系統 微量流量調整メータリングバルブ 1系統
- ユーティリティ 電気: AC200V三相4.0KVA
冷却水: 3.0L/min以上0.03MPa以上0.1MPa以下25℃以下循環
寸法: 1190mmW×750mmD×(1285)mmH

